## 上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 400

产品名称	上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 400
公司名称	伯东企业(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:KRI 型号:eH 400 产地:美国
公司地址	ec@hakuto-vacuum.cn
联系电话	021-50463511 13918837267

## 产品详情

美国 KRI 霍尔离子源 eH 400上海伯东代理美国原装进口 KRI 霍尔离子源 eH 400 低成本设计提供高离子电流,霍尔离子源 eH 400 尺寸和离子能量特别适合中小型的真空系统,可以控制较低的离子能量,通常应用于离子辅助镀膜,预清洗和低能量离子蚀刻.尺寸: 直径= 3.7 "高= 3"放电电压 / 电流: 50-300eV / 5a操作气体: Ar, Xe, Kr, O2, N2, 有机前体KRI 霍尔离子源 eH 400 特性 可拆卸阳极组件 - 易于维护; 维护时, \*大限度地减少停机时间; 即插即用备用阳极 宽波束高放电电流 - 均匀的蚀刻率; 刻蚀效率高; 高离子辅助镀膜 IAD 效率 多用途 -适用于 Load lock / 超高真空系统 等离子转换和稳定的功率控制KRI 霍尔离子源 eH 400 技术参数:

型号 eH 400 / eH 400 LEHO 供电 DC magnetic confinement

- 电压 40-300 V VDC

- 离子源直径~ 4 cm- 阳极结构模块化电源控制eHx-3005A

配置

- 阴极中和器 Filament, Sidewinder Filament or Hollow Cathode

 - 离子束发散角度
 > 45 ° (hwhm)

 - 阳极
 标准或 Grooved

 - 水冷
 前板水冷

 - 底座
 移动或快接法兰

- 高度 - 直径 3.0'

- 加工材料 金属电介质半导体

- 工艺气体 Ar, Xe, Kr, O2, N2, Organic Precursors

- 安装距离

6-30 "

- 自动控制

控制4种气体

\* 可选: 可调角度的支架; SidewinderKRI <u>霍尔离子源</u> eH 400 应用领域: 离子辅助镀膜 IAD 预清洁 Load lock preclean In-situ preclean Low-energy etching III-V Semiconductors Polymer Substrates1978 年 Dr. Kaufman 博士在美国创立 Kaufman & Robinson, Inc 公司,

研发生产<u>考夫曼离子源</u>,<u>霍尔离子源</u>和<u>射频离子源</u>. 美国<u>考夫曼离子源</u>历经 40 年改良及发展已取得多项专利. 离子源广泛用于离子清洗 PC, 离子蚀刻 IBE, 辅助镀膜 IBAD, 离子溅射镀膜 IBSD 领域, 上海伯东是美国<u>考夫曼离子源</u>中国总代理.

若您需要进一步的了解详细信息或讨论,请参考以下联络方式:

上海伯东: 罗女士